

SD 335 ... SD 340 □

SD 335/337/339 npn-, SD 336/338/340 pnp-Silizium-Epitaxie-Planar-Transistoren mittlerer Leistung für allgemeine NF-Anwendungen.

Als komplementäre Transistorpaare sind sie für NF-Leistungsendstufen und für Treiberstufen in NF-Verstärkern mit hohen Ausgangsleistungen verwendbar.

Bauform 6 TO126

Wärmewiderstand $R_{thja} \leq 110 \text{ K/W}$
 $R_{thjc} \leq 10 \text{ K/W}$

Grenzwerte: (gültig für den Betriebstemperaturbereich)

	SD 335/336	337/338	339/340	
$ U_{CBO} $	45	60	80	V
$ U_{CEO} $	45	60	80	V
$ U_{EBO} $		5		V
$ I_C $		1,5		A
$ I_{CM} $		2		A
$ I_B $		0,2		A
$P_{tot} \quad (\vartheta_c \leq 25^\circ\text{C})$		12,5		W
$P_{tot} \quad (\vartheta_a \leq 40^\circ\text{C})$		1		W
ϑ_j		150		$^\circ\text{C}$
ϑ_a		-55 ... +125		$^\circ\text{C}$

Statische Kennwerte ($\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5 \text{ K}$)

	SD 335/337/339			SD 336/338/340			
	min	typ	max	min	typ	max	
$ U_{(BR)CBO} \quad (I_C = 1 \text{ mA})$							V
SD 335/336	45			45			V
SD 337/338	60			60			V
SD 339/340	80			80			V
$ U_{(BR)CEO} \quad (I_C = 50 \text{ mA})$							V
SD 335/336	45			45			V
SD 337/338	60			60			V
SD 339/340	80			80			V

$ U_{(BR)EBO} (I_E = 1 \mu A)$	5		5	V
$ I_{CBO} (U_{CB} = 30 V)$	< 1	100	< 10	100 nA
$ I_{EBO} (U_{EB} = 5 V)$	< 5 nA	10 μA	< 5 nA	10 μA
$ U_{CEsat} ^1) (I_C = 500 mA,$ $ I_B = 50 mA)$	200	500	280	500 mV
$ I_C = 100 mA, I_B = 10 mA)$	70		80	mV
$ U_{BEsat} ^1) (I_C = 500 mA,$ $ I_B = 50 mA)$	870		930	mV
$ U_{BE} ^1) (U_{CE} = 2 V,$ $ I_C = 500 mA)$	830	1 000	835	1 000 mV
$ h_{21E} (U_{CE} = 2 V, I_C = 5 mA)$	25	80	25	80
$ U_{CE} = 2 V, \text{ Gruppe A}$	40	65	40	75
$ I_C = 150 mA)^1) \text{ Gruppe B}$	63	110	63	115
Gruppe C	100	150	100	140
		250		250

$ h_{21E} (U_{CE} = 2 V,$ $ I_C = 500 mA)^1)$	25	90	25	108
--	----	----	----	-----

Paarungsbedingung:

$\frac{h_{21E1}}{h_{21E2}} (U_{CE} = 2 V,$ $ I_C = 150 mA)^1)$	$\leq 1,4$
--	------------

Dynamische Kennwerte: ($\vartheta_a = 25^\circ C - 5 K$)

$f_T (U_{CE} = 10 V,$ $ I_C = 50 mA, f = 20 MHz)$	50	125	75	210	MHz
---	----	-----	----	-----	-----

¹⁾ Messung erfolgt impulsmäßig